

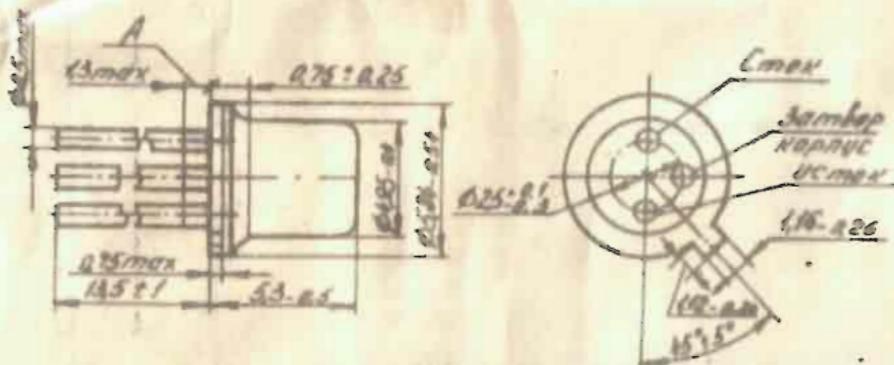


ТРАНЗИСТОРЫ КН103В, КН103Ж, КН103И, КН103К,
КН103Л, КН103М

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые диффузионно-планарные полевые транзисторы КН103В, КН103Ж, КН103И, КН103К, КН103Л, КН103М в металлокерамическом корпусе с управляющим р-п переходом и каналом р-типа, предназначенные для работы во входных каскадах усилителей низкой частоты, усилителей постоянного тока и ключевых схемах, изготавливаемые для народного хозяйства.

Для климатического исполнения УХЛЗ.



В зоне А размеры выводов не регламентированы

Масса не более 1 г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

(при $t_{\text{окр. ср.}} = (25 \pm 10) \text{ } ^\circ\text{C}$)

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Н о р м а	
	не менее	не более
Начальный ток стока (Иси=-10 В, Изн=0 В), мА		
КШОЗВ	0,3	2,5
КШОЗБ	0,35	3,8
КШОЗИ	0,8	1,8
КШОЗК	1	5,5
КШОЗЛ	1,8	6,6
КШОЗМ	3	12
Круговые характеристики (Иси=-10 В, Изн=0 В, $f = 1000 \text{ Гц}$), мА/В		
КШОЗВ	0,4	2,4
КШОЗБ	0,5	2,8
КШОЗИ	0,8	2,8
КШОЗК	1	3,3
КШОЗЛ	1,8	3,8
КШОЗМ	1,3	4,4
Напряжение отсечки (Иси=-10 В, $I_{\text{с.отс}}=10 \text{ мкА}$), В		
КШОЗВ	0,4	1,5
КШОЗБ	0,5	2,2
КШОЗИ	0,6	3
КШОЗК	1	4
КШОЗЛ	2	6
КШОЗМ	2,8	7
Ток утечки катодра (Иси=0 В, Изн=10 В), нА		20
Коэффициент шума (Иси=-5 В, Изн=0 В), дБ		3
Входная емкость (Иси=-10 В, Изн=0 В, $f = 4 \cdot 10^4 \text{ Гц}$), пФ		20
Прочная емкость (Иси = -10 В, Изн = 0 В, $f = 4 \cdot 10^4 \text{ Гц}$), пФ		6

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 ШТ. ТРАНЗИСТОРОВ:

золото -

6,5195г.
000063г.

в том числе:

золото - г/мм на 3 выводах длиной ($13,5 \pm 1$) мм

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТСЯ

СВИДЕТЕЛЬ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КН103Е, КН103Ж, КН103И, КН103К, КН103Л, КН103М

соответствуют техническим условиям 3.365.000 ТУ1.

Штамп ОТК

БТК 06-38

Штамп Государственной
приемки

Пере проверка произведена _____
дата

Штамп ОТК

Штамп Государственной
приемки

УКАЗАНИЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ

1. Допускается применение транзисторов, изготовленных в обычном климатическом исполнении, в аппаратуре, предназначенной для эксплуатации во всех климатических условиях, при покрытии транзисторов непосредственно в аппаратуре лаком (в 3...4 слоя) типа УР-201 по ТУ 6-10-863-84 или ЗИ-730 по ГОСТ 20824-81 с последующей сушкой в соответствии с РМ II 070.046-82.

2. Допустимое значение статического потенциала 500 В по ОСТ II 073.062-84.

3. Транзисторы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки и паяльником. Режим и условия монтажа транзисторов в аппаратуре - по ОСТ II 336.907.0-79.

Температура припой (260 ± 5) ° С.

Время пайки не более 4 с.

Время лужения выводов $(0,2 \pm 0,01)$ с.

Минимально-допустимое расстояние от корпуса до места пайки и лужения 3 мм.

Число допустимых перепадов выводов транзисторов при проведении монтажных (оборочных) операций 3.

Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода 5 мм.

4. Типовой режим применения $I_{на} = 0 В$, $I_{ос} = -10 В$.

5. Запрещается подавать на затвор отрицательное напряжение более 0,5 В.

6. Транзисторы должны обеспечивать надежность с использованием спирто-канифольных неактивированных и спирто-канифольных некоррозийных слабоактивированных флюсов (не более 25 % канифоли) без дополнительной подготовки в течение 12 мес. с момента изготовления.

7. Транзисторы должны допускать покрытие влагозащитными лаками и композициями, содержащими в своем составе органические растворители.

8. При эксплуатации транзисторов в условиях механических воздействий их необходимо крепить за корпус.

9. При изгибе выводов должна быть исключена возможность передачи усилия на стеклянный изолятор или место присоединения вывода к корпусу транзистора, чтобы не произошло нарушения спая вывода со стеклянным изолятором, вздутия и потери герметичности прибора.

10. Транзисторы должны сохранять работоспособность, целостность конструкции, герметичность, стойкость покрытий и маркировочных обозначений при очистке в спирто-бензиновой смеси (1:1) при вибропромывке с частотой $(50 \pm 5) Гц$ и амплитудой колебаний не 1,0 мм в течение 4 мин.